

第 22 回 Cat-CVD 研究会 プログラム

2025 年 6 月 20 日 (金)

会場：じゅうろくプラザ 5F (口頭発表) 中会議室 1、(ポスターセッション) 小会議室 1

9:00～10:00 研究会 受付

10:00～10:05 開会挨拶 (実行委員長：岐阜大学 伊藤 貴司)

10:05～11:35 特別講演 I

S-01 : 10:05～10:35

大型熱フィラメント CVD 法によるダイヤモンド合成と電子舌センサへの応用

大曲 新矢 (産業技術総合研究所)

S-02 : 10:35～11:05

低温プロセスにおけるラジカルの効果

武山 真弓, 佐藤 勝 (北見工業大学)

S-03 : 11:05～11:35

5—10 $\mu\text{m}/\text{min}$ を超える高速製膜 Cat-CVD 法

松村 英樹 (北陸先端科学技術大学院大学)

11:35～13:00 休 憩

13:00～14:30 特別講演 II

S04 : 13:00～13:30

Cat-CVD の化合物半導体デバイスへの適用

奥 友希, 戸塚 正裕, 西口 浩平, 佐々木 肇 (三菱電機株式会社)

S-05 : 13:30～14:00

加熱触媒により生成した分解種による表面処理

和泉 亮 (九州工業大学)

S-06 : 14:00～14:30

硫化モリブデン薄膜の酸素化・水素化による p 型化及び N 型化について

土田 正道, 許 誠浩, 清水 耕作 (日本大学)

14:30～14:45 休 憩

14:45～15:45 特別講演Ⅲ

S-07：14:45～15:15

原子状水素アニールによる表面改質
部家 彰，住友 弘二（兵庫県立大学）

S-08：15:15～15:45

Cat-CVD によるペロブスカイト太陽電池への窒化 Si 膜堆積
大平 圭介，Huynh Thi Cam Tu（北陸先端科学技術大学院大学）

15:45～16:00 休憩

16:00～16:45 特別講演Ⅳ・一般講演

S-09：16:00～16:30

電気二重層キャパシタ用カーボンナノウォール電極の開発
伊藤 貴司，原 拓也，石川 弘明，大野 純弥，田邊 耕生，田中 賀久，山田 繁
（岐阜大学）

O-01：16:30～16:45

Cat-CVD 法による Si 低温エピタキシャル成長膜の構造特性評価
新倉 ちさと，廣戸 孝信，高野 美和子，李 玲穎，三成 剛生
（物質・材料研究機構）

16:45～18:15 ポスターセッション（会場：小会議室 1）

18:15～18:25 閉会挨拶（実行委員長：岐阜大学 伊藤 貴司）

ポスターセッション

- P-01 触媒体線の加熱による低侵襲なダイヤモンド水素終端チャネルの形成
野田 和哉, 白髪 純也, 蔭浦 泰資, 大曲 新矢 (産業技術総合研究所)
- P-02 縦型ホットワイヤー装置による試料表面に対する輻射熱抑制
土屋 凜晟, 森永 楓, 片宗 優貴, 和泉 亮 (九州工業大学)
- P-03 ホットワイヤーを用いた NH_3 分解種による低温酸化 Si 膜表面の構造変化
Kim Minwoo¹, 小佐々 誠¹, 堀田 将², 片宗 優貴¹, 和泉 亮¹
(¹九州工業大学, ²北陸先端科学技術大学院大学)
- P-04 原子状水素アニールによる高分子電解質膜の表面形態の変化と反応機構
北山 育暉, 住友 弘二, 部家 彰 (兵庫県立大学)
- P-05 高分子膜/水晶振動子を用いた原子状水素センサの開発
藤野 雄飛, 住友 弘二, 部家 彰 (兵庫県立大学)
- P-06 原子状水素を用いたレジスト密度分布評価の検討
井手 哉斗, 住友 弘二, 山川 進二, 原田 哲男, 部家 彰 (兵庫県立大学)
- P-07 水素ラジカル処理による Si/SiO₂多層膜中への水素拡散
井上 暁広, 藤澤 知輝, 出戸 智大, 松尾 直紀, 江畑 裕登, 西 悠貴, 山田 繁, 伊藤 貴司
(岐阜大学)
- P-08 カーボンナノウォールのウォール先端への絶縁膜コーティング
石川 弘明, 原 拓矢, 山田 繁, 伊藤 貴司 (岐阜大学)